



华晶分立器件

3DD2498

低频放大管壳额定双极型晶体管

1. 概述与特点

3DD2498 硅 NPN 型高反压大功率晶体管，主要用作 21 英寸彩电开关电源，该产品采用台面结构工艺。其特点如下：

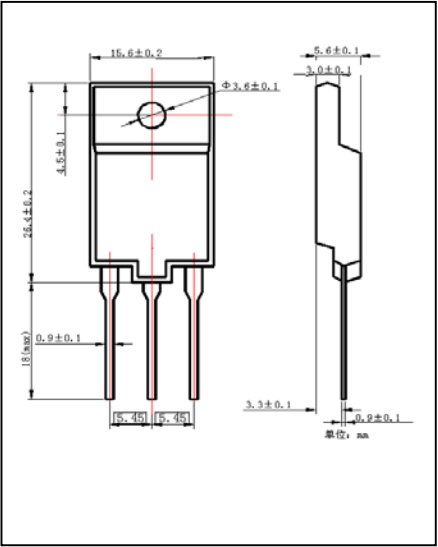
- 击穿电压高、漏电流小
- 开关速度快
- 饱和压降低
- 电流特性好
- 封装形式：TO-3P(H)IS

2. 电特性

2.1 极限值

除非另有规定， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

| 参 数 名 称   |                          | 符 号       | 额 定 值   | 单 位                |
|-----------|--------------------------|-----------|---------|--------------------|
| 集电极-发射极电压 |                          | $V_{CE0}$ | 600     | V                  |
| 集电极-基 极电压 |                          | $V_{CB0}$ | 1500    | V                  |
| 发射极-基 极电压 |                          | $V_{EB0}$ | 5       | V                  |
| 集电极电流     |                          | $I_C$     | 6       | A                  |
| 耗散功率      | $T_a=25^{\circ}\text{C}$ | $P_{tot}$ | 3       | W                  |
|           | $T_c=25^{\circ}\text{C}$ |           | 50      |                    |
| 结温        |                          | $T_j$     | 150     | $^{\circ}\text{C}$ |
| 贮存温度      |                          | $T_{stg}$ | -55~150 | $^{\circ}\text{C}$ |



2.2 电参数

除非另有规定， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

| 参 数 名 称                                             | 符 号           | 测 试 条 件                                                              | 规 范 值 |    |     | 单 位           |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|---------------|
|                                                     |               |                                                                      | 最小    | 典型 | 最大  |               |
| 集电极-基极截止电流                                          | $I_{CB0}$     | $V_{CB}=1500\text{V}, I_E=0$                                         |       |    | 1   | mA            |
| 发射极-基极截止电流                                          | $I_{EB0}$     | $V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$                                            |       |    | 10  | $\mu\text{A}$ |
| 共发射极正向电流传输比的静态值                                     | $h_{FE}^a$    | $V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$                                    | 8     |    | 40  |               |
| 集电极-发射极饱和电压                                         | $V_{CEsat}^a$ | $I_C=4\text{A}, I_B=0.8\text{A}$                                     |       |    | 5   | V             |
| 基 极-发射极饱和电压                                         | $V_{BEsat}^a$ | $I_C=4\text{A}, I_B=0.8\text{A}$                                     |       |    | 1.2 | V             |
| 下降时间                                                | $t_f$         | $V_{CC}=105\text{V}, I_C=4\text{A}$<br>$2I_{B1}=-I_{B2}=0.8\text{A}$ |       |    | 1   | $\mu\text{s}$ |
| 特征频率                                                | $f_T$         | $V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.1\text{A}$<br>$f=0.3\text{MHz}$            | 1     |    |     | MHz           |
| a: 脉冲测试 $t_p \leq 300 \mu\text{s}, \delta \leq 2\%$ |               |                                                                      |       |    |     |               |

无锡华润华晶微电子有限公司

地址: 江苏省无锡市梁溪路 14 号 电话: 0510-85807228-3399 传真: 0510-85807228-2227  
邮编: 214061 网址: <http://www.crhj.com.cn> 电邮: [apply@crhj.com.cn](mailto:apply@crhj.com.cn)



### 3. 特性曲线

